

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-244585

(43)Date of publication of application : 19.09.1997

(51)Int.Cl.

G09G 3/36
 G02F 1/133
 H03K 3/356
 H03K 17/10
 H03K 17/687
 H03K 19/0185

(21)Application number : 08-046454

(71)Applicant : TOPPAN PRINTING CO LTD
TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 04.03.1996

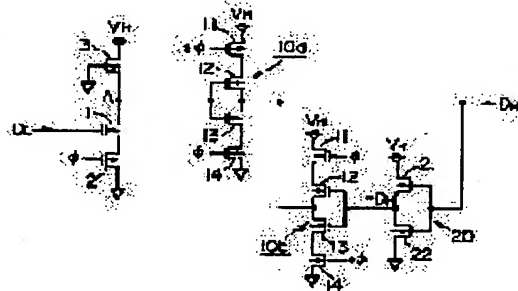
(72)Inventor : CHIN GIYOSHIIYOU
NANZAKI HIRONORI
TAGUCHI TAKASHI

(54) LEVEL SHIFTER CIRCUIT WITH LATCH FUNCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a level shifter circuit in which the driving capacity is high, smaller number of transistors is used to constitute the circuit and the number of rows is reduced in the layout of the driver ICs of a liquid crystal display device.

SOLUTION: When a clock signal ϕ is '1' (an inverted clock signal $\bar{\phi}$ is '0', the digital signals of a voltage V_H system, which are made by inverting the digital signals of a voltage V_L (for example, 3 volts) system being inputted to the gate of an Nch field effect transistor(FET) 1, are inputted to a three state inverter 10a and the inverter 10a inverts and outputs the inputted signals. Moreover, when the signal ϕ is '0', the inverter 10a is put in a high impedance state and the signals ϕ keep the output state the same as the state immediately before the signal ϕ becomes '0' by the loop which is formed by an inverter 20 and a three state inverter 10b.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 13.03.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 22.06.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

特開平9-244585

(43) 公開日 平成9年(1997)9月19日

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 9 G	3/38		G 0 9 G	3/38
G 0 2 F	1/133		G 0 2 F	1/133
H 0 3 K	3/356		H 0 3 K	17/10
	17/10			D
	17/587			F

審査請求 有 請求項の数 7 O L (全 15 頁) 最終頁に図 2

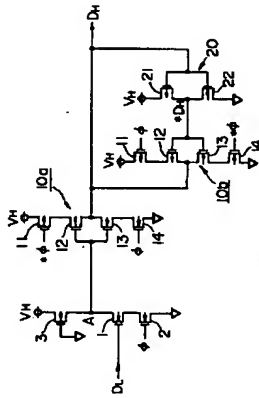
(21) 出願番号	特開平8-46454	(71) 出願人	000003193 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号
(22) 出願日	平成8年(1996)3月4日	(71) 出願人	000003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72) 発明者	陳 曉翔 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内
		(72) 発明者	南 崎 浩樹 神奈川県川崎市幸区堀川町580番の15 株式会社東芝半導体システム技術センター内
		(74) 代理人	井 理 士 志 賀 正 武 (外2名) 最終頁に図 2

(54) 発明の名称 ラッチ機能付きレベルシフト回路

(57) 【要約】

【課題】 ドライバ能力が高く、かつ、より少ないトランジスタで構成することができるばかりでなく、液晶表示装置のドライバICのレイアウトにおいてローの数を削減することができるラッチ機能付きレベルシフト回路を提供すること。

【解決手段】 クロック信号φが「1」(反転クロック信号φが「0」)の時3ステートインバータ10aには、Nch FET 1のゲートに入力される電圧V_L系のデジタル信号を反転した、電圧V_H系のデジタル信号が入力され、3ステートインバータ10aは、入力された信号をさらに反転して出力する。また、クロック信号φが「0」になると、3ステートインバータ10aはハイインピーダンス状態となり、インバータ20と3ステートインバータ10bとにより形成されるループによってクロック信号φが「0」になる直前の出力状態を保持する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 2値デジタル信号である制御信号が入力され、該制御信号がハイレベルの時、外部から入力される第1レベルのデジタル信号を該第1レベルよりも高いレベルである第2レベルのデジタル信号に変換して出力するレベル変換手段と、

前記制御信号が入力され、該制御信号がハイレベルの時、前記レベル変換手段から出力される第2レベルのデジタル信号の論理を反転して外部へ出力する第1の論理反転手段と、

前記第1の論理反転手段から出力される第2レベルのデジタル信号を反転する第2の論理反転手段と、

前記制御信号が入力され、該制御信号がローレベルの時、前記第2の論理反転手段から出力される第2レベルのデジタル信号を前記第1の論理反転手段の出力へ出力する第3の論理反転手段とからなることを特徴とするラッチ機能付きレベルシフト回路。

【請求項2】 前記レベル変換手段は、

前記制御信号が入力されるゲートと接地されたソースを有する第1のNチャネル電界効果トランジスタと、前記第1のNチャネル電界効果トランジスタのドレインと接地されたソースと前記第1レベルのデジタル信号が入力されるゲートを有する第2のNチャネル電界効果トランジスタと、

前記第2のNチャネル電界効果トランジスタのドレインと接地されたドレインと接地されたゲートと前記第2レベルのデジタル信号のハイレベルと同一電圧値が印加されたソースとを有するPチャネル電界効果トランジスタとからなり、前記第2のNチャネル電界効果トランジスタのドレインと前記Pチャネル電界効果トランジスタのドレインとの接続点が前記第1の論理反転手段の入力に接続され、かつ、前記第1、第2のNチャネル電界効果トランジスタおよびPチャネルFETがオンになった時の前記接続点における電圧が、

$$V_A = V_H \cdot \frac{(R_{N1} + R_{N2})}{(R_P + R_{N1} + R_{N2})} < V_H$$

(但し、V_Aは前記第1、第2のNチャネル電界効果トランジスタおよびPチャネルFETがオンになった時の前記接続点における電圧、V_Hは第2レベルのデジタル信号のハイレベルの電圧、R_{N1}は第1のNチャネル電界効果トランジスタのオン抵抗、R_{N2}は第2のNチャネル電界効果トランジスタのオン抵抗、R_PはPチャネルFETのオン抵抗、V_{th}は前記第1の論理反転手段の入力しきい値電圧)なる条件を満たすことを特徴とする請求項1記載のラッチ機能付きレベルシフト回路。

【請求項3】 前記レベル変換手段は、

前記制御信号が入力されるゲートと接地されたソースを有する第1のNチャネル電界効果トランジスタと、前記第1のNチャネル電界効果トランジスタのドレインと接地されたソースと前記第1レベルのデジタル信号が

入力されるゲートを有する第2のNチャネル電界効果トランジスタと、

前記第2のNチャネル電界効果トランジスタのドレインと接地されたドレインと前記制御信号が入力されたゲートと前記第2レベルのデジタル信号のハイレベルと同一電圧値が印加されたソースとを有するPチャネル電界効果トランジスタとからなり、前記第2のNチャネル電界効果トランジスタのドレインと前記Pチャネル電界効果トランジスタのドレインとの接続点が前記第1の論理反転手段の入力に接続されていることを特徴とする請求項1記載のラッチ機能付きレベルシフト回路。

【請求項4】 前記第1の論理反転手段の出力と接続されたゲートと前記第2レベルのデジタル信号のハイレベルと同一電圧値が印加されたソースと前記第1の論理反転手段の入力と接続されたドレインとを有するPチャネル電界効果トランジスタを具備することを特徴とする請求項3記載のラッチ機能付きレベルシフト回路。

【請求項5】 前記第2のNチャネル電界効果トランジスタの代わりに、複数の前記第1レベルのデジタル信号が入力され、該複数の第1レベルのデジタル信号の能力が所定の条件を満たした時にオンとなる論理回路を具備することを特徴とする請求項2ないし4のうちのいずれか1項記載のラッチ機能付きレベルシフト回路。

【請求項6】 前記論理回路は、第3、第4のNチャネル電界効果トランジスタと、第3のNチャネル電界効果トランジスタのソースと第4のNチャネル電界効果トランジスタのドレインと接地され、第3、第4のNチャネル電界効果トランジスタの各ゲートに入力される2つの第1レベルのデジタル信号が共にハイレベルの時オンとなることを特徴とする請求項5記載のラッチ機能付きレベルシフト回路。

【請求項7】 第1レベルの3ビットのデジタルデータをデコードし、該デコード結果を第1レベルよりも高いレベルである第2レベルのデジタル信号に変換して出力すると共に外部から入力される制御信号によって、該デコード結果を保持するデコーダであって、該デコーダは、

請求項2記載のラッチ機能付きレベルシフト回路と、第1ないし第4の請求項6記載のラッチ機能付きレベルシフト回路と、

1つの入力端と2つの出力端を有し、前記請求項2記載のラッチ機能付きレベルシフト回路から出力される第2レベルのデジタル信号に基づいて、前記1つの入力端に入力された信号を2つの出力端のうちのいずれか1つから出力する切換手段であって、前記第1ないし第4の請求項6記載のラッチ機能付きレベルシフト回路の各々に対応して設けられる第1ないし第4の切換手段とからなり、

前記請求項2記載のラッチ機能付きレベルシフト回路の第2のNチャネル電界効果トランジスタのゲートには、前記

3ビットのデジタルデータの最下位ビットが入力され、前記第1の請求項6記載のラッチ機能付きレベルシフト回路の第3、第4のNチャネル電界トランジスタの各ゲートには前記3ビットのデジタルデータの第2ビットの反転信号と、最上位ビットの反転信号が入力され、前記第2の請求項6記載のラッチ機能付きレベルシフト回路の第3、第4のNチャネル電界トランジスタの各ゲートには前記3ビットのデジタルデータの第2ビットの信号と、最上位ビットの反転信号が入力され、前記第3の請求項6記載のラッチ機能付きレベルシフト回路の第3、第4のNチャネル電界トランジスタの各ゲートには前記3ビットのデジタルデータの第2ビットの反転信号と、最上位ビットの信号が入力され、前記第4の請求項6記載のラッチ機能付きレベルシフト回路の第3、第4のNチャネル電界トランジスタの各ゲートには前記3ビットのデジタルデータの第2ビットの信号と、最上位ビットの信号が入力されていることを特徴とするデコーダ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置のTFT (thin film transistor) 駆動用ドライバICに用いて好適なラッチ機能付きレベルシフト回路に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より、液晶表示装置の駆動方式としてTFT駆動方式がある。TFT駆動方式は階調表示の品質が高く、画面の明るさやコントラストが優れ、表示品質が高く、という特徴を有している。また、応答速度が速い、視野角が広いといった画質以外の性能面においても優れている。このTFT駆動方式の原理を、図10を参照して説明する。この図において、50は薄膜トランジスタであり、外部からソース線51を通して電圧が入力され、ゲート線52に電圧が印加された時、ソース線51に入力された電圧を液晶層53に印加する。これにより液晶層53の液晶分子は角度を変え、バックライト等からの光を通させる。また階調表示は、ソース線51に入力する電圧を変化させ、液晶層53の液晶分子の角度を制御することにより行われる。

【0003】一般に、液晶ディスプレイは図10に示す回路をマトリクス状に多数 (例えばVGA (video graphics array) の場合、640×480画素) 配置することによって構成されている。このような液晶ディスプレイにおいては、TFT駆動用のドライバIC (以下、単にドライバICという) を用いて各行の薄膜トランジスタに各々画素データに基づく電圧を印加し、1行毎に順次薄膜トランジスタをONして行くことにより、画像の表示を行っている。

【0004】上述したドライバICには、従来、外部から入力される階調制御用のデジタルデータを保持するデ

ータラッチ部と、入力されたデジタルデータに基づいて液晶ディスプレイの各画素トランジスタに電圧を印加するドライバ細等の回路が含まれている。そして、データラッチ部においては、低消費電力化を図るために駆動電圧を従来の5Vから3Vに低下させた他のデジタルICに合わせるため、駆動電圧を3Vにしている。また、ドライバ部においては、液晶表示装置の応答特性を向上させるため、すなわち、ごく短時間で液晶分子の角度を変化させるために、より高い電圧が必要となり、このため駆動電圧は従来の5Vの電圧が用いられている。このように、ドライバICには1つのIC内に異なる電圧で駆動する回路が混在するため、データラッチ部から出力される3V系の信号を5V系の信号に昇圧するレベルシフト部が設けられている。

【0005】ここで、図11に従来のデータラッチ部とレベルシフト部の回路構成を示す。この図において、60はデータラッチ部であり、70はレベルシフト部である。また、データラッチ部60は、各々PチャネルまたはNチャネル電界効果トランジスタ (以下、それぞれPchFET、NchFETという) によって構成される。回路61a、61bおよび回路62からなっている。回路61aは直列に接続されたPchFET611、612とNchFET613、614からなり、PchFET611のソースは3Vの電圧が印加され、NchFET614のソースは接地されている。

【0006】そして、NchFET614のゲートには3Vの電圧で「1」を表し、接地電位で「0」を表すデジタル信号 (以下、3V系のデジタル信号という) であるクロック信号φが入力されている。また、PchFET611のゲートには上記クロック信号φを反転した反転クロック信号φ* (3V系) が入力されている。さらに、PchFET612とNchFET613のゲートには、外部からデジタルデータのビット信号D (3V系) が入力され、また、PchFET612のドレインとNchFET613ドレインの接続点は、回路62のPchFET621とNchFET622のゲートおよびレベルシフト部70のNchFET702のゲートにそれぞれ接続されている。

【0007】回路62は、直列に接続されたPchFET621とNchFET622からなり、PchFET621のソースは3Vの電圧が印加され、NchFET622のソースは接地されている。また、PchFET621のドレインとNchFET622のドレインの接続点は、回路61bのPchFET612およびNchFET613のゲートと、レベルシフト部70のNchFET701のゲートにそれぞれ接続されている。【0008】回路61bは、回路61aと同一の構成を有するが、クロック信号φはPchFET611のゲートに入力され、反転クロック信号φ*はNchFET614のゲートに入力されている。また、PchFET614

12のドレインとNchFET613のドレインとの接続点は回路62のPchFET621およびNchFET622のゲートに接続されている。

【0009】ここで、上述した回路61aは、例えばクロック信号φが「0」、すなわち、反転クロック信号φ*が「1」の時、PchFET611とNchFET614は共にOFFになり、出力はハイインピーダンス状態となる。一方、クロック信号φが「1」、すなわち、反転クロック信号φ*が「0」の時、PchFET611とNchFET614は共にONになり、この状態でPchFET612とNchFET613のゲートに「0」が入力されるとPchFET612がON、NchFET613がOFFとなり、回路61aからは電圧3V、すなわち3V系のデジタル信号の「1」が出力される。また、PchFET612とNchFET613のゲートに「1」が入力されるとPchFET612がOFF、NchFET613がONとなり、回路61aからは接地電位、すなわち3V系のデジタル信号の「0」が出力される。

【0010】このように、回路61aは、クロック信号φが「1」の時はインバータとして機能し、「0」の時はその出力がハイインピーダンス状態となる一種の3ステートインバータとなる。そして、回路62はPchFET621およびNchFET622のゲートに「1」が入力されるとPchFET621がOFF、NchFET622がONとなり、回路61aから接地電位となり「0」が出力される。また、「0」が入力されるとPchFET621がON、NchFET622がOFFとなり、回路61aからは電圧3V、すなわち「1」が出力される。したがって、回路62はインバータとして機能する。

【0011】一方、レベルシフト部70は、NchFET701、702およびPchFET703、704により構成されている。PchFET703、704のソースにはそれぞれ5Vの電圧が印加され、NchFET701、702のソースは各々接地されている。そして、NchFET701とPchFET703のドレイン同士は接続され、その接続点はPchFET704のゲートと接続されている。また、NchFET702とPchFET704のドレイン同士も接続され、その接続点はPchFET703のゲートと接続されている。さらにNchFET702のドレインとPchFET704のドレインの接続点は、図示せぬドライバ部に接続されている。

【0012】上述した図11の回路における動作は、まず、データラッチ部60において、クロック信号φが「1」、反転クロック信号φ*が「0」の時、回路61

bの出力はハイインピーダンス状態になり、これに対し、回路61aは可動状態になって、外部から入力されるデジタル信号Dを反転してその信号φ*Dをレベルシフト部70のNchFET702のゲートと回路62に出力する。また、回路62は反転されたデジタル信号φ*Dをさらに反転してレベルシフト部70のNchFET701のゲートに出力する。

【0013】例えば回路61aに入力されたデジタル信号Dが「1」であった場合、レベルシフト部70のNchFET702のゲートには「0」が、また、NchFET701のゲートには「1」が入力される。これにより、NchFET701がON、また、NchFET702がOFFになるので、PchFET704はONとなり、図示せぬドライバ部に対して5V系のデジタル信号の「1」 (電圧5V) が出力される。

【0014】一方、デジタル信号Dが「0」であった場合、レベルシフト部70のNchFET702のゲートには「1」が、また、NchFET701のゲートには「0」が入力される。これにより、NchFET701がOFF、NchFET702がONとなり、PchFET704はONとなり、図示せぬドライバ部に対して5V系のデジタル信号の「0」 (接地電位) が出力される。

【0015】次にクロック信号φが「0」、反転クロック信号φ*が「1」になると、回路61aの出力がハイインピーダンス状態になり、回路61bが可動状態になる。上述した回路61aから出力された信号は、回路61bと回路62とにより形成されるループによって保持され、これにより、レベルシフト部70から出力されている電圧も、次にクロック信号φが「1」、反転クロック信号φ*が「0」になるまで保持される。このように、図11の回路は、外部から入力される3V系のデジタル信号を5V系のデジタル信号に昇圧すると共に、クロック信号φに従って出力状態を保持する。

【0016】ここで、上述したドライバICを例えばCMOS (complementary metal oxide semiconductor) により実装にIC化する場合、そのICチップのレイアウトは、図12に示すように、3Vの電圧によって駆動する回路を列に配した回路列 (以下、3V系のローという) 80と、5Vの電圧によって駆動する回路を列に配した回路列 (以下、5V系のローという) 90の2種類のローが必要になる。一例として、この図において各ローの幅は約80μmの長さを有し、各ローは約40μmの間隔をもって形成されるものとする。

【0017】図13は上述したローの詳細なレイアウトを示すもので、この図では3V系のローにおける図11のデータラッチ部60の回路62のレイアウトを示している。この図において、81は3Vの電源ラインであ

路) FET11~14をインバータ31におきかえ、PchFET3をそのON抵抗RN だけで図示したものである。そして、接続点Aの電位VAは、インバータ31が入力されたデジタル信号を「0」として認識することができると、入力値電圧Vthと上式の関係を満たすようにRN が決定される。

【0032】10a、10bは、それぞれ図11の回路61aおよび回路61bと同様の構成をとる一種の3ステートインバータであり、3ステートインバータ10aはクロック信号φが「0」(反転クロック信号φが「1」)の時、出力がハイインピーダンス状態となり、「1」の時、出力がハイインピーダンス状態となり、クロック信号φが「0」の時、インバータとして機能する。また、3ステートインバータのPchFET12およびNchFET13のゲートには、「1」を電圧VH、「0」を電圧0Vによって表す電圧VH系のデジタル信号が入力され、また、各PchFET11のソースは電圧VHが印加されており、電圧VH系のデジタル信号を出力する。

【0033】20は図11の回路62と同様の構成をとるインバータであり、PchFET21およびNchFET22のゲートには3ステートインバータ10aから出力される電圧VH系のデジタル信号φが入力されている。そして、PchFET21のソースには電圧VHが印加されており、電圧VH系のデジタル信号φを出力する。また、PchFET23のドレインとNchFET1のドレインとの接続点Aは、3ステートインバータ10aの入力(PchFET12およびNchFET13のゲート)と接続され、3ステートインバータ10aの出力(PchFET12のドレインとNchFET13のドレインの接続点)は外部と接続されると共に、インバータ20の入力(PchFET21およびNchFET22のゲート)に接続されている。

【0034】さらに、インバータ20の出力(PchFET21のドレインとNchFET22のドレインの接続点)は3ステートインバータ10bの入力と接続され、3ステートインバータ10bの出力は、3ステートインバータ10aの出力、インバータ20の入力、および、外部と接続されている。すなわち、3ステートインバータ10bとインバータ20は、3ステートインバータ10aの出力側においてループを形成している。

【0035】次に上述したラッチ機能付きレベルシフト回路の動作について説明する。まず、クロック信号φが「1」(反転クロック信号φが「0」)の場合、NchFET2HONとなり、この時、NchFET1のゲートに「1」(電圧VH)が入力されると、NchFET

T1はONになって3ステートインバータ10aには前述した電圧VAが入力される。また、NchFET1のゲートに「0」(接地電位)が入力されると、NchFET1はOFFになって3ステートインバータ10aに入力される。このように、本実施形態のラッチ機能付きレベルシフト回路に入力された電圧VH系のデジタル信号は、NchFET1、2およびPchFET3により、電圧VH系のデジタル信号に昇圧される。したがって、本実施形態のラッチ機能付きレベルシフト回路のレベルシフト部と言える。

【0036】そして、3ステートインバータ10aは、クロック信号φが「1」、反転クロック信号φが「0」であるためインバータとして機能し、電圧VAが入力された場合は、インバータ20および外部へ電圧VH(電圧VH系のデジタル信号の「1」)を出力し、電圧VHが入力された場合は接地電位(電圧VH系のデジタル信号の「0」)を出力する。また、インバータ20は3ステートインバータ10aから出力された信号を反転して3ステートインバータ10bへ出力する。ここで、3ステートインバータ10bは、クロック信号φが「1」、反転クロック信号φが「0」であるため、その出力はハイインピーダンス状態になっており、これより3ステートインバータ10a、10bから同時に信号が出力されることはない。

【0037】この状態からクロック信号φが「0」(反転クロック信号φが「1」)に転じると、NchFET2はOFFとなり、NchFET1のゲートに入力される電圧VH系のデジタル信号の内容に関わらず、3ステートインバータ10aには電圧VHが入力される。ここで、3ステートインバータ10aはPchFET11およびNchFET14がそれぞれOFFになっているため、その出力はハイインピーダンス状態となり、入力された電圧VHを反転して出力することはない。

【0038】一方、この時3ステートインバータ10bはインバータとして機能し、クロック信号φが「0」(反転クロック信号φが「1」)に転ずる直前に、インバータ20から出力されていたデジタル信号を反転して外部とインバータ20へ出力する。これにより、クロック信号φが「0」の時、3ステートインバータ10bとインバータ20によって形成されるループによってクロック信号φが「0」(反転クロック信号φが「1」)に転ずる直前のデジタル信号の状態が保持される。したがって、3ステートインバータ10a、10bおよびインバータ20は、本実施形態のラッチ機能付きレベルシフト回路のラッチ部と言える。

【0039】このように、本実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路においては、クロック信号φが「1」の時、入力された電圧VH系のデジタル信号DL

を電圧VH系のデジタル信号に昇圧して出力すると共に、クロック信号φが「0」に転じた時は、その直前の出力信号の状態を保持する。

【0040】また、本実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路の電源電圧は、すべて電圧VHであるため、ラッチ部およびレベルシフト部の電源電圧を1つに統合することができる。そして、本実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路の出力インピーダンスは図11に比べて低くなるため、駆動能力が向上することになり、さらに、本実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路を構成するトランジスタの数は13個であり、図11の回路に比べ3個のトランジスタを削減することができる。

【0041】[第2実施形態] 図3に第2実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路を示す。この図において、図1に示すラッチ機能付きレベルシフト回路の各部に相当する部分については同一の符号を付し、その説明を省略する。ここで、3ステートインバータ10a、10bおよびインバータ20内部の各構成は図中省略されているが、図1の各部と同様の構成を有している。すなわち、図3において、例えば3ステートインバータ10aには、実際はクロック信号φおよび反転クロック信号φが共に入力されているが、3ステートインバータ10aはクロック信号φが「1」の時インピーダンスとして機能するので、図中にはクロック信号φのみを記載している。また、これと同様の理由で、3ステートインバータ10bには反転クロック信号φのみを記載している。ここで、図3に示すラッチ機能付きレベルシフト回路が図1のものとは異なる点は、PchFET3のゲートにもクロック信号φが入力されている点である。

【0042】以下に本実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路の動作について説明する。まず、クロック信号φが「0」の時、NchFET2がOFF、PchFET3がONになり、3ステートインバータ10aに電圧VHが入力される。また、この時図中A点と3ステートインバータ10a間に存在する浮遊容量Cに充電が行われる。そして、クロック信号φが「1」になると、NchFET2がON、PchFET3がOFFになる。

【0043】この時、NchFET1のゲートに「1」が入力された場合はNchFET1はONとなり、浮遊容量Cに充電された電荷がNchFET1、2を通じて放電され、3ステートインバータ10aには「0」が入力される。また、NchFET1のゲートに「0」が入力された場合はNchFET1がOFFになった場合は、浮遊容量Cに充電された電荷が3ステートインバータ10aに印加され、すなわち3ステートインバータ10aには「1」が入力されることになる。

【0044】以後の動作は第1実施形態と同様、クロック信号φが「1」の時、3ステートインバータ10a

に入力された電圧VH系のデジタル信号を反転して外部とインバータ20へ出力する。また、クロック信号φが「0」に転じると、その直前の出力信号の状態を保持する。本実施形態のラッチ機能付きレベルシフト回路によれば、NchFET2とPchFET3がクロック信号φに従って交互にON、OFFするので、第1実施形態のように、NchFET1、2が共にONになった場合、電流がPchFET3、NchFET1、2を介して流れるといったことがなく、これにより、レベルシフト部における消費電流を大幅に低減することができる。また、本実施形態においても、第1実施形態と同様に、出力インピーダンスを低くすることができ、ため、次段の回路に対する駆動能力が向上する。そして、ラッチ機能付きレベルシフト回路の電源電圧は、全てVHであるため、ラッチ部およびレベルシフト部の電源電圧を1つに統合することができ、ローを系統化することができ。さらに、本実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路を構成するトランジスタの数は13個であり、図11の回路に比べ、3個のトランジスタを削減することができる。

【0045】[第3実施形態] 図4に第3実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路を示す。この図において、図3に示すラッチ機能付きレベルシフト回路の各部に相当する部分については同一の符号を付し、その説明を省略する。図4において、図3のラッチ機能付きレベルシフト回路と異なる点は、PchFET4が追加されている点である。このPchFET4のゲートは3ステートインバータ10a、10bの各出力と接続され、ドレインは3ステートインバータ10aの入力と接続されている。また、ソースには電圧VHが印加されている。

【0046】ここで、前述した第2実施形態において、クロック信号φが「1」の時、NchFET1のゲートに「0」が入力された場合は、浮遊容量Cに充電された電荷が3ステートインバータ10aに印加され、これにより3ステートインバータ10aに「1」が入力されることは既に述べたが、その際、何らかの要因で浮遊容量Cに充電された電荷が放電されてしまうおそれがある。そのような場合、3ステートインバータ10aに「1」を保持する正電圧(ここでは5V)を供給し続けることができないなり、正常に動作しない可能性がある。第3実施形態においては追加されたPchFET4は、そのような事態を避けるため、3ステートインバータ10aに入力する電圧VH系のデジタル信号の「1」の電圧を維持するものである。

【0047】以下、本実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路の動作について説明する。まず、クロック信号φが「0」の時、NchFET2がOFF、PchFET3がONとなり、3ステートインバータ10aに電圧VHが入力されると、クロック信号φが「1」になり、また、N

chFET1のゲートに「0」が入力されると、浮遊容量Cに充電された電荷が3ステートインバータ10aに印加され、これにより「1」が入力される。この時、3ステートインバータ10aは、「0」を出力するため、PchFET4はONとなつて、3ステートインバータ10aに電圧VHが入力される。

[0048]したがって、この時点以降、クロック信号が「1」で、NchFET1のゲートに「0」が入力されている間は、PchFET4がON状態に固定され、3ステートインバータ10aの入力には電圧VH系デジタル信号の「1」が安定して入力される。また、本実施形態において、クロック信号が「0」の場合は3ステートインバータ10bとインバータ20からなるループによってクロック信号が「0」になる直前の出力状態を保持する。このため、何らかの要因により浮遊容量Cの放電経路が存在したとしても、3ステートインバータ10aは安定して動作することができ、ローを一系統化する点、ラッチ部およびレベルシフト部の電源電圧を1つに統合することができ、ローを一系統化することができ、第1点、第2実施形態と同様の効果を有している。

[0049]（第4実施形態）図5に第4実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路を示す。この図に示すラッチ機能付きレベルシフト回路は、図4のラッチ機能付きレベルシフト回路と異なる点は、NchFET1の代わりに論理回路5が追加されている点である。この論理回路5には種々の回路が考えられるが、何れにせよ外部より入力される電圧VL系のデジタル信号DLi-DLnの状態が、論理回路5に付された条件を満たす場合のみ、論理回路5はONとなる。

[0050]以下、図6ないし図8に上述した論理回路5の具体的な実施形態を示す。図6は上述した論理回路5として、入力される電圧VL系のデジタル信号DLi-DLnがすべて「1」の時ONとなるように、NchFET6-1～6-nの互いのドレインとソースを接続した回路6を用いた形態であり、論理回路6は一種のANDゲートの動作をする。

[0051]すなわち、クロック信号が「1」の時、NchFET6-1～6-nのゲートにすべて「1」が入力された場合、3ステートインバータ10aに「0」が入力され、出力デジタル信号DHは「1」となる。また、この時NchFET6-1～6-nのゲートのうち、いずれか1つでも「0」が入力された場合は、3ステートインバータ10aには「1」が入力され、出力されるデジタル信号DHは「0」となる。さらに、この時PchFET4のゲートには「0」が入力されるので、3ステートインバータ10aの入力に電圧VHが印加さ

系のデジタル信号DHは「0」となる。また、この状態からクロック信号が「0」に転じると、3ステートインバータ10aは、ハイインピーダンス状態となり、インバータ20および3ステートインバータ10bにより形成されるループによって、外部に出力されるデジタル信号DHは「0」のまま保持される。

[0057]そして、デジタル信号DLaおよびDLbが共に「1」（*DLa、*DLbは共に「0」）の時にクロック信号が「1」（すなわち、反転クロック信号*φは「0」）になった時に上述した動作と同様の動作が行われる。以上をまとめると、電圧VL系のデジタル信号DLa、DLbが共に「0」または「1」の時、外部へ出力される電圧VH系のデジタル信号DHは「0」となり、デジタル信号DLaが「0」、DLbが「1」、もしくは、デジタル信号DLaが「1」、DLbが「0」の時、デジタル信号DHは「1」となる。このように、図8のラッチ機能付きレベルシフト回路においては、論理回路7によって、入力される電圧VL系のデジタル信号DLa、DLbのエクスクルージブANDがとられ、その結果は昇圧され、また、クロック信号φに従って保持される。

[0058]なお、図8のラッチ機能付きレベルシフト回路にも、クロック信号φが「1」、かつ、論理回路7がOFFの状態になった時、3ステートインバータ10aに入力される電圧VL系のデジタル信号の「1」の状態を補償する目的で、図6と同様にPchFET4を追加してもよい。

[0059]このように、本実施形態におけるラッチ機能付きレベルシフト回路によれば、簡単な回路の追加により、図4に示すラッチ機能付きレベルシフト回路にさらに機能を追加することができるので、より少ないトランジスタにより、多機能なレベルシフト回路を構成することができ、よって、液晶表示装置のドライバICのチップをより小型化することができる。

[0060]（第5実施形態）図9に本実施形態の回路を示す。本実施形態では、上述したラッチ機能付きレベルシフト回路を用い、3入力-8出力のデコード回路を構成した場合について説明する。図9において、40は第1実施形態で述べた図1のラッチ機能付きレベルシフト回路と同一回路であり、NchFET1のゲートには電圧VL系の3ビットのデジタルデータの第1ビット（最下位ビット）D0が入力されている。また、NchFET2のゲートにはクロック信号φが入力されている。

[0061]41a～41dはラッチ機能付きレベルシフト回路40とほぼ同様のラッチ機能付きレベルシフト回路であるが、NchFET1とNchFET2の間には、NchFET8が追加されている点が異なっている。すなわち、NchFET8のドレインはNchFET1のソースに接続され、NchFET8のソースはNchFET2のドレインに接続されている。ここで、図

9において、ラッチ機能付きレベルシフト回路41aのみ、その内部構成を図示しているが、ラッチ機能付きレベルシフト回路41b～41dについても同様の構成を有している。

[0062]ラッチ機能付きレベルシフト回路41aのNchFET1のゲートは、インバータ9bによって反転された第2ビットDL2の反転信号*DL2が出力されている信号ライン32と接続され、NchFET8のゲートは、インバータ9aにより反転された第3ビット（最上ビット）DL3の反転信号*DL3が出力されている信号ライン30と接続されている。ラッチ機能付きレベルシフト回路41bのNchFET1のゲートは、第2ビットDL2が出力されている信号ライン33と接続され、NchFET8のゲートは、信号ライン30と接続されている。

[0063]ラッチ機能付きレベルシフト回路41cのNchFET1のゲートは、信号ライン33と接続され、NchFET8のゲートは、第3ビットDL3が出力されている信号ライン31と接続されている。ラッチ機能付きレベルシフト回路41dのNchFET1のゲートは、信号ライン32と接続され、NchFET8のゲートは、信号ライン30と接続されている。さらに、ラッチ機能付きレベルシフト回路41a～41dの各NchFET2のゲートには、クロック信号φがそれぞれ入力されている。

[0064]42a～42dは切換回路であり、各々の構成を有しているため切換回路42aのみ、その構成を図示する。42aおよび26aはそれぞれNchFETとPchFETであり、NchFET25aのドレインとPchFET26aのソースは互いに接続され、ラッチ機能付きレベルシフト回路41aの3ステートインバータ10aと接続されている。また、NchFET25aのソースとPchFET26aのドレインも互いに接続され、その接続点a1からはデコード信号SH1が出力される。

[0065]そして、NchFET25aのゲートは、ラッチ機能付きレベルシフト回路40のインバータ20の出力と接続され、PchFET26aのゲートはその入力からラッチ機能付きレベルシフト回路40のインバータ20の出力と接続されたインバータ27aの出力と接続されている。28aはNchFETであり、そのドレインはNchFET25aのソースとPchFET26aのドレインの接続点a1に接続されている。また、ソースは接地され、ゲートはラッチ機能付きレベルシフト回路40の3ステートインバータ10aの出力と接続されている。

[0066]また、NchFET25b、PchFET26b、インバータ27b、NchFET28bも、上述したNchFET25a、PchFET26a、インバータ27a、NchFET28aと同様の接続関係を

きレベルシフト回路の構成を示すブロック図である。

【図4】 この発明の第3実施形態によるラッチ機能付きレベルシフト回路の構成を示すブロック図である。

【図5】 この発明の第4実施形態によるラッチ機能付きレベルシフト回路の構成を示すブロック図である。

【図6】 同ラッチ機能付きレベルシフト回路の論理回路部分の一具体例を示すブロック図である。

【図7】 同ラッチ機能付きレベルシフト回路の他の形態を示すブロック図である。

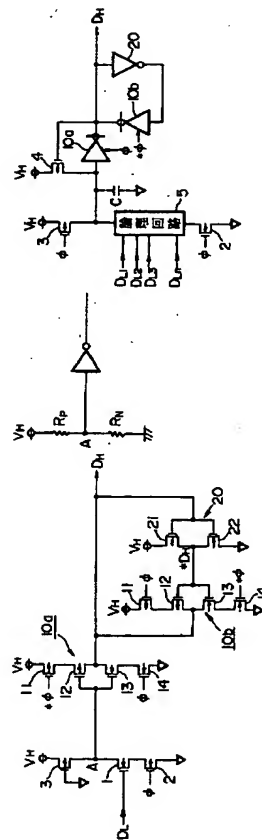
【図8】 同ラッチ機能付きレベルシフト回路の論理回路部分の他の具体例を示すブロック図である。

【図9】 この発明の第5実施形態による3入力-8出力のデコーダ回路の構成を示すブロック図である。

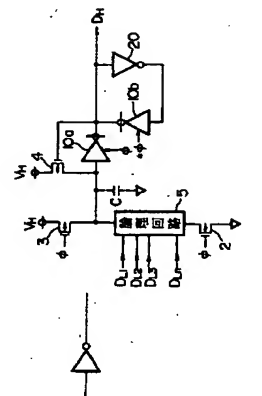
【図10】 TFT駆動方式の原理を説明するための説明図である。

【図11】 従来のドライバIC内におけるデータラッチ部とレベルシフト部の回路構成を示す電気接続図であ

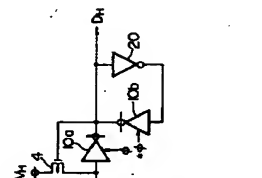
【図1】



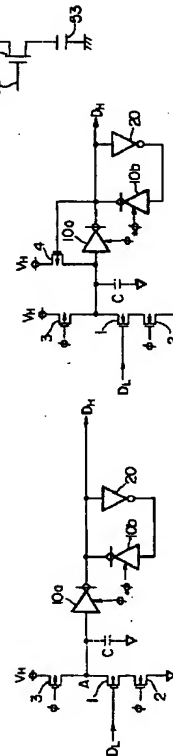
【図2】



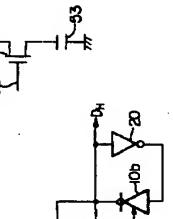
【図5】



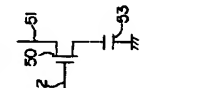
【図3】



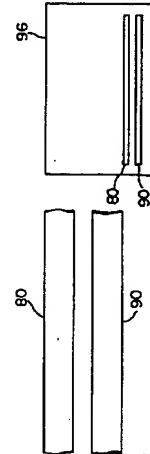
【図4】



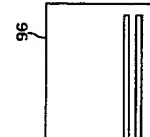
【図10】



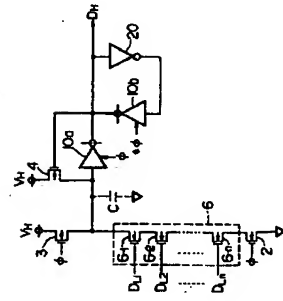
【図12】



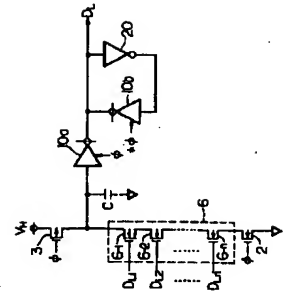
【図15】



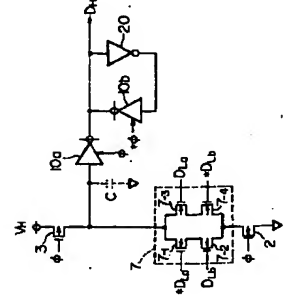
【図6】



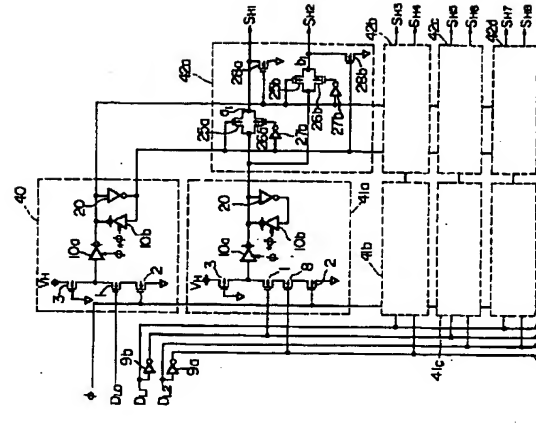
【図7】



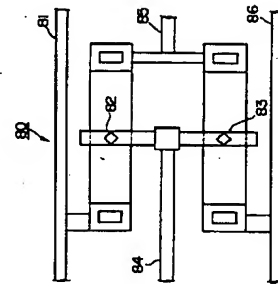
【図8】



【図9】



【図13】



【図14】

